Faculty of Electrical - Electronics Bộ Môn Cơ Sở KỸ Thuật Điện Tử





CHƯƠNG 1 : LỊNH KIỆN BÁN DẪN 2 LỚP VÀ ỨNG DỤNG



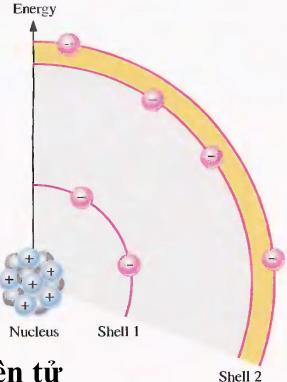
Giới thiệu

► FIGURE 1-1

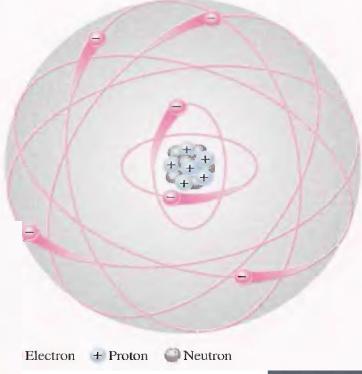
The Bohr model of an atom showing electrons in orbits around the nucleus, which consists of protons and neutrons. The "tails" on the electrons indicate motion.

FIGURE 1-3

Energy increases as the distance from the nucleus increases.

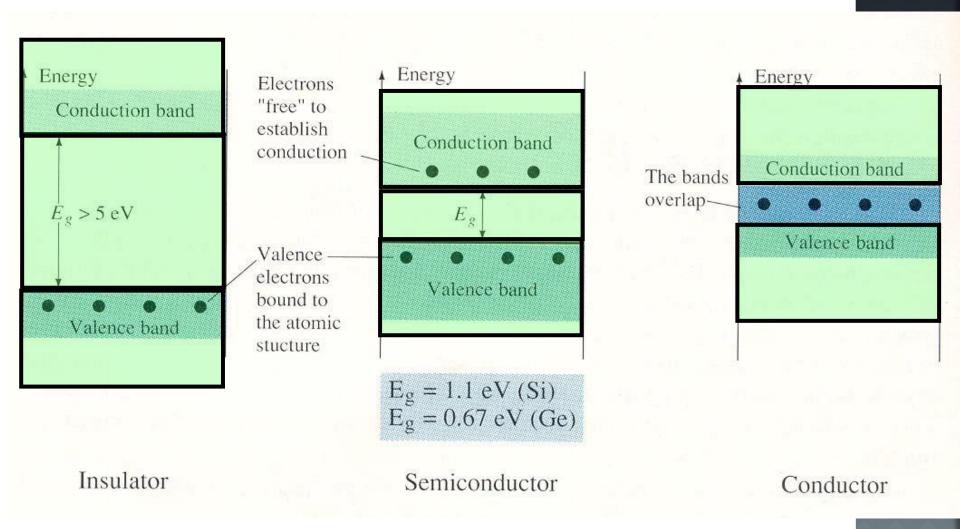


Cấu trúc nguyên tử





Giới thiệu



Giản đồ năng lượng



Bán dẫn thuần

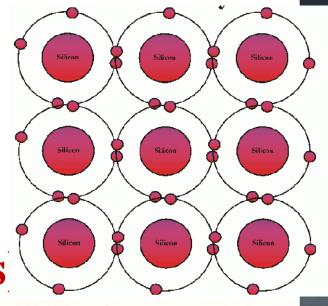
Vật liệu phổ biến

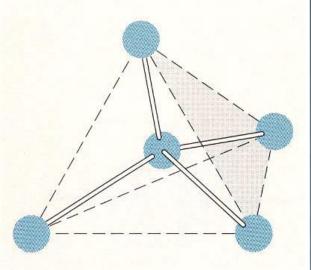
Si: Silicon

Ge: germanium

Không pha tạp chất

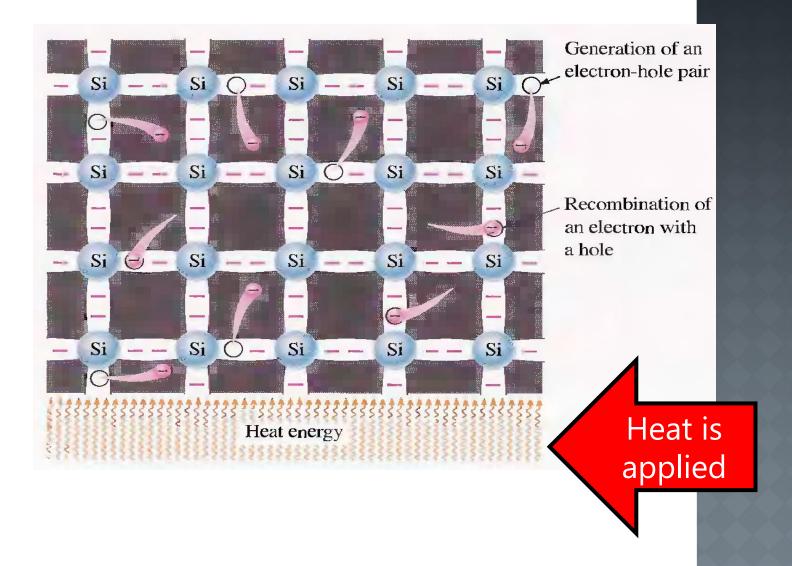
n(electrons) = p(holes)





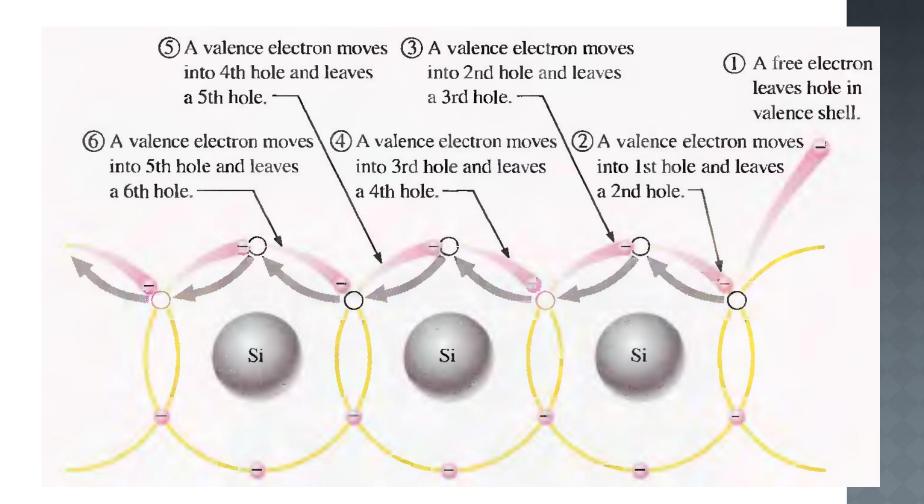


Bán dẫn thuần





Dòng electron và lỗ trống



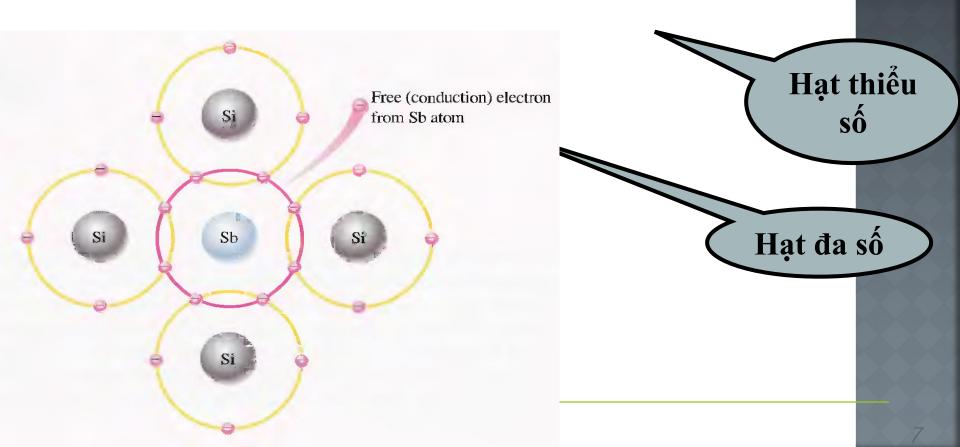


Bán dẫn pha tạp chất

Loai N (Negative)

- ☐ BD thuần + tạp chất hóa trị 5
- → tăng số e

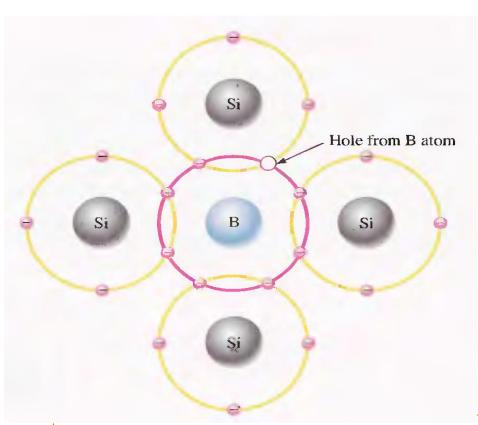
$$n_N >> p_N$$

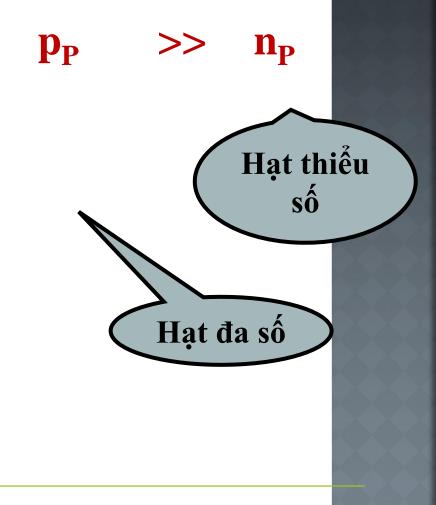


Bán dẫn pha tạp chất

Loai P(Positive)

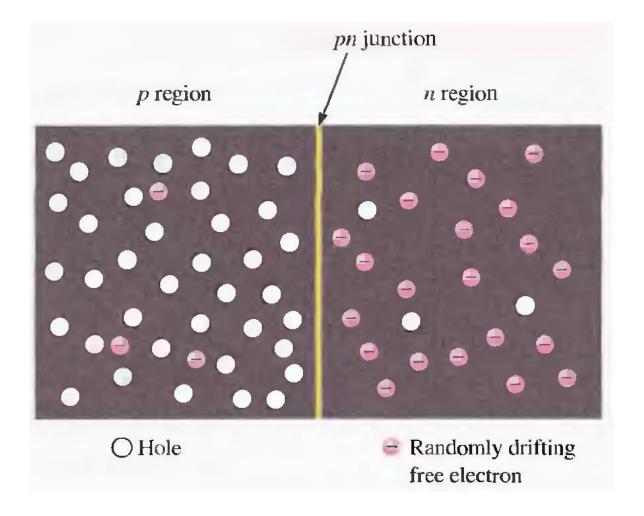
- ☐ BD thuần + tạp chất hóa trị 3
- → Tăng số lỗ trống





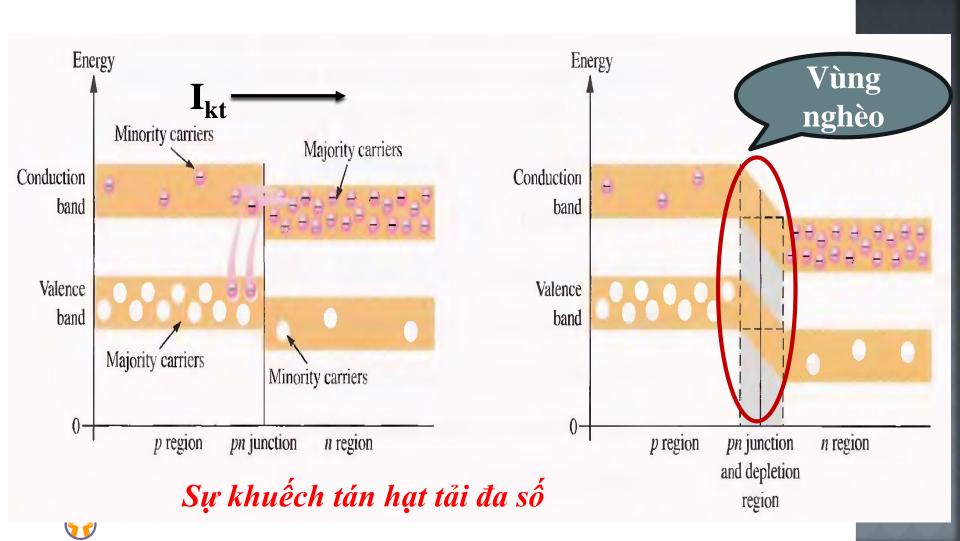


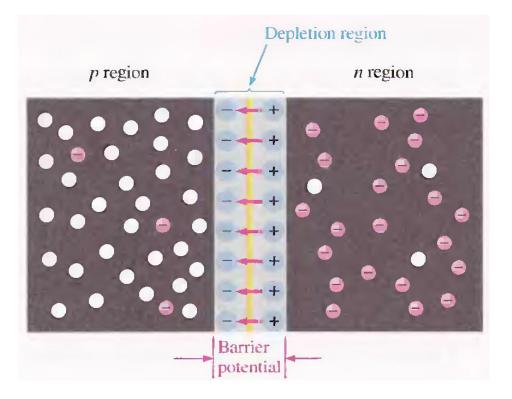
Tiếp giáp PN





Tiếp giáp PN





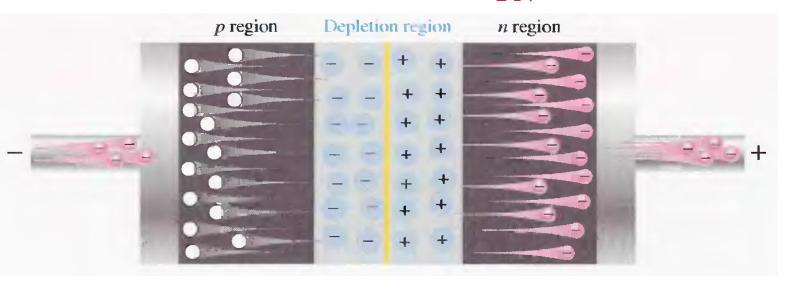
Diện trường (hàng rào điện thế) trong miền nghèo

$$E_{tx}=V\gamma=0.7V$$
 (Si)
0.3V (Ge)

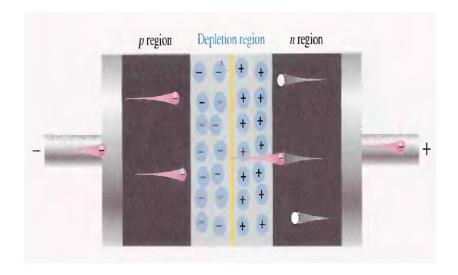
$$I_{PN} = 0$$



Phân cực ngược
$$(V_N > V_P)$$
 $I_{PN} = 0$

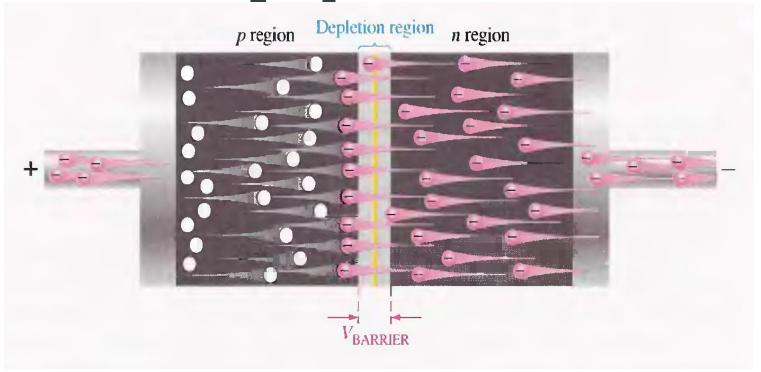


Chiều chuyển động hạt đa số





Phân cực thuận $(V_N < V_P)$



$$I_{p-n} = I_{kt} - I_{tr} = I_{S} \left(e^{V_{D}/\eta V_{T}} - 1 \right)$$

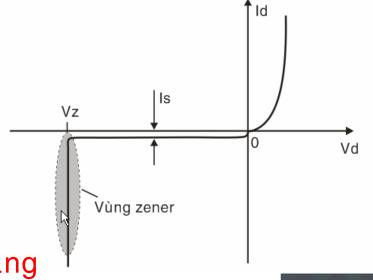


Đặc tuyến Volt-Ampere 20 19 18 17 16 15 14 13 12 Defined polarity and 11 direction for graph 10 ► ID Forward-bias region $(V_D > 0 \text{ V}, I_D > 0 \text{ mA})$ 6 $V_D(V)$ 0.7 -40 -30-20-100.3 0.5 $-0.1 \mu A$ No-bias 0.2 µA $(V_D = 0 \text{ V}, I_D = 0 \text{ mA})$ Reverse-bias region 0.3 µA $(V_D < 0 \ V, I_D = -I_S)$ $-0.4 \, \mu A$



Đánh thủng ngược

Đánh thủng là phá huỷ đặc tính van của tiếp giáp. Tiếp giáp dẫn điện hai chiều. Phân loại:



<u>Đánh thủng thác lũ</u>: Do hạt thiểu số tăng tốc theo điện áp gây ion hóa các nguyên tử qua va chạm \rightarrow dòng thác lũ.

<u>Đánh thủng xuyên hầm</u>: Khi mật độ tap chất trong bán dẫn tăng \rightarrow E_{TX} lớn gây ra hiệu ứng xuyên hầm lôi kéo các e^- trong vùng hóa trị của lớp P vượt qua E_{tx} chảy sang lớp N

<u>Đánh thủng nhiệt</u>: Xảy ra do tích lũy nhiệt trong vùng tiếp xúc vượt quá giới hạn → Hư hỏng vĩnh viễn tiếp xúc

